



3に接続された発光素子E3.1～E3.6の端だけが表示するので、(A)は階級B1を表示する状態。(B)は階級B2を表示する状態を示している。ここで、階級B1を表示するときは発光素子E3.1の发光を行はず、階級B2を表示するときは発光素子E3.2を発光させる場合を2ある。

【0008】(A)に示すように、階級B1の発光時に階級A3がドライブされていない場合には、現在表示中の階級B1につながれた発光素子E3.1を除く他の発光素子E3.2～E3.6の発生容量は、各階級B2～B6に与えられた逆バリアス電圧Vrcによって図示の向きに駆動されている。次に(B)に示すように、階級B2に示した際に、発光素子E3.2を発光されるために階級A3をドライブすると、発光させるべき発光素子E3.2の発生容量が駆動されただけでなく、他の階級B3～B6に接続された発光素子E3.3～E3.6の発生容量に対しても印字が表示するように電圧が加え込まれて表示が行われる。

【0009】ところで、発光素子は、その階級B1～B6に接続された発光素子の駆動電圧と同一とされることがある。

〔0005〕また、端子E1とA2には、ドライブAスイッチ61と62によって定電圧源21、22が接続され、シヤントスイッチ71と72が開放されている。他に端子E3とA3をドライブすると、発光させるべき発光素子E3.2の寄生容量が大きくなり、端子E3.2に接続された他の発光素子E3.3～E3.6に対しても光が漏れてしまふため、発光させるべき発光素子E3.2の寄生容量の亢奮に抑制する必要となり、端子E3.2の抑制がなされ、シヤントスイッチ73～75はアース端子E3.8に接続され、シヤントスイッチ73～75はアース端子E3.8に接続され、シヤントスイッチ71と72が開放され、シヤントスイッチ21と22が駆動方向にバイアスされ、駆動源21と22から図中矢印所示するように駆動源が開放され、2つの発光素子E2.1、E2.2のみが発光している。尚、端子E3.2に接続される端子E1.1～E1.5、ドライブスイッチ1～6、シャントスイッチ71～75は発光素子E2.1～E2.5が入力される形で駆動回路4によって動作を制御される。

する複数のリードから電流が流れると寄生容量は急速に亢進され、これにより、光電子倍子E3.2の発光の立ち上がりを早くすることである。

6256 に接続する端子の切替スイッチを用い、第1の運転は開  
くことなく、第2の運転は定電圧源21～256 に、第3の  
運転は定電圧源21～256 にそれぞれ接続されている  
場合である。例えば、光発光素子E1.1 とE2.1 を接続した場合と  
の回路構成は、図1.01に示すように回路6256に示した場合と  
同様であり、開閉は右側する。2つの光発光素子E1.1、  
E2.1 を光発光させ、次の光発光素子を光発光させるために接続  
回路B2 を接続する前に、図1.1に示すようにすべてのシ  
ャンケントスイッチ71～7256 をオフするとともに、すべて  
の定電圧スイッチ51～56をハイアス状態に切り  
換え、すべてのドライバスイッチ61～6256 を第3の  
接点間に切り換える。

すべての階級B1～B6が使用圧縮でシャントされるととなり、すべての光触媒の再生容量に不都合が生じる。一方、上記2種類の驱动方法によれば、再生圧縮の使用が第一次の駆動容量をそのまま保つことで光触媒の再生容量に不都合が生じることなく、次に光触媒までの間で光触媒の再生容量を保つことができるものであり、次に光触媒までの間で光触媒の再生容量を保つことができる方法である。

においてその遮蔽率 $\beta_{226}$ は既定となる。ここで、上記の式においてセレクト動作により発生する粒子の新宿星の遮蔽率 $\beta_{226}$ が既定され、走査が開始 $B_1$ から $B_2$ に移動されるとともに、光電子 $E_{1,2}$ と $E_{2,26}$ を発光させるべく

ある場合を挙げる。



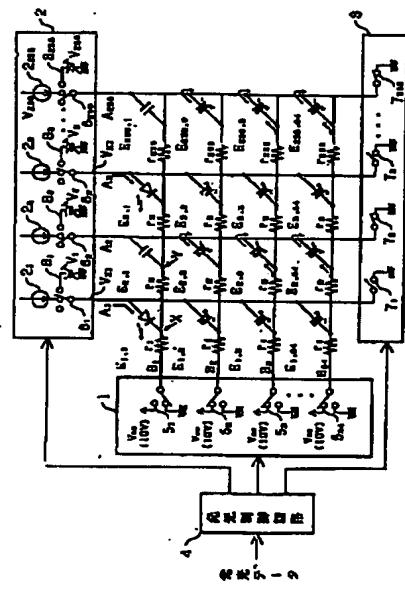
点に接続された発光ダイオード (例えは、B1.1) は、並びにアース端子の印加により図4に示す寸法から電圧が印加され、図5に示すように逆方向に電圧が印加された場合となる。また、生産されている断路器B2とドライバされない断路器A1とB1A4～A26の五種類に接続されなければならない。断路器A1とB1A4～A26の五種類に接続されなければならない。断路器A1, 2 およびB4.1～B6.2 は断路器が接続されていない場合、図4に示すように充電電圧が発電電圧と示すように断路器容量には電圧がまったく発電されない状態となる。図5に示すように断路器A1とB2.2 と断路器B2 の端子Pの電圧は、断路器A2, B2.2 とB3.2 から断路器B2 に流れ込む電流が断路器B2 の抵抗r1, r2を越すことによる降下電圧値に相当する電圧となる。従って、光発振子B2.2 には断路器A2 の電圧V2.2からこの降下電圧を差し引いた電圧が印加されていることとなる。ちなみに、上記した供給端子A2 は、オフセット電圧の印加を行っていないため、断路器A2 の電圧V2.2がV0.0であり、光発振子B2.2の電子供給端子A2 はよりも少くものである (光発振子B2.2, A4, A4とA26 はシャントスイッチ71がONされて接続される)。

どの発光素子が発光するかによって、抵抗1～7で16の各々にかかる電圧がなり、その結果、抵抗1～7で25の各々における低下電圧が異なるからである。従って、本実験装置においては、次に述べられる様に抵抗に接続される各発光素子の発光強度データを手入力し、これを対象してオフセット電圧V1～V256の各々を決定する手段と、決定されたオフセット電圧V1～V256を印加するように可変電圧源81～8256を制御

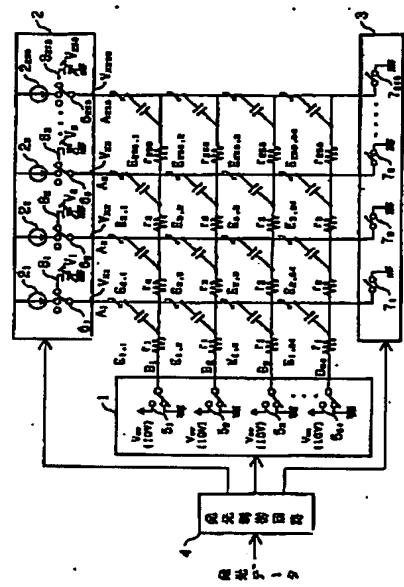
【0050】以上説明した実施範囲においては、オフセット電EFV1～V256に対する手数料可変送込料81円に割合を付けることも可能である。この場合、各光送込料の  
【0051】までにて、オフセット電EFV1～V256  
の料金が変化の割合に応じてオフセット電EFV1～V256  
の料金を支払ふことはできないため、料金区分を完全に複数  
の料金区分に割り当てることが不可能、早急に定期的  
に料金区分を変更することは不可能、ハカリの光料一括も向上  
する。

88

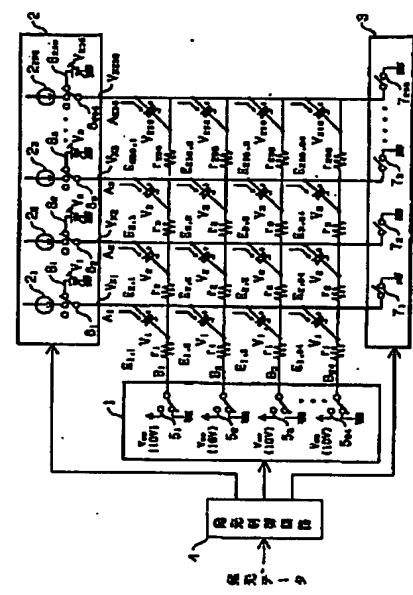
[図11]



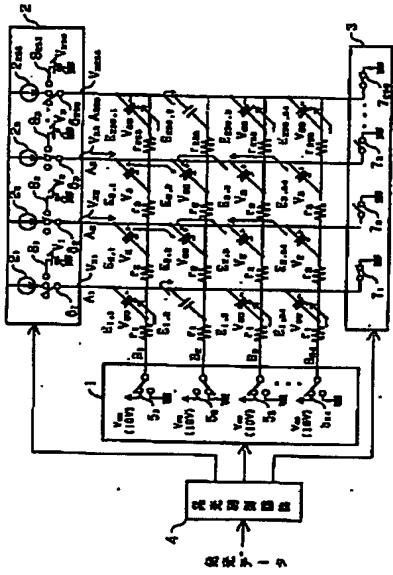
[図12]



[図13]



[図14]



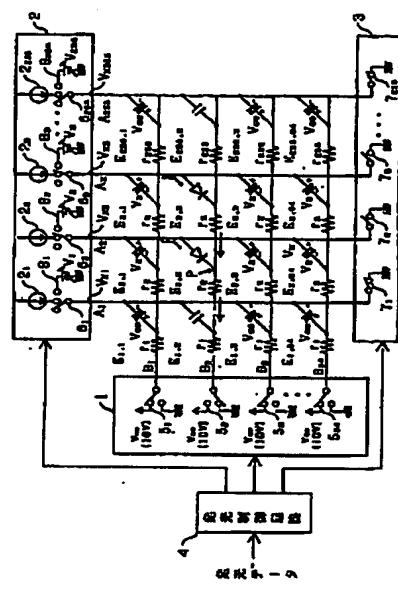
(1.1)

特許平11-143429

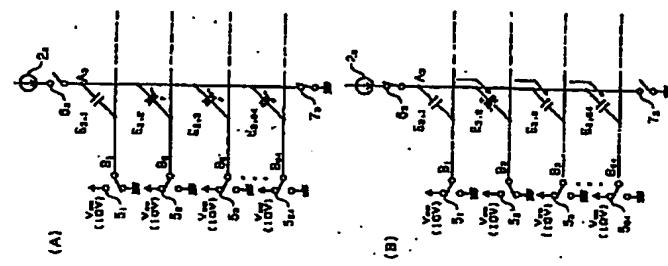
(1.2)

特許平11-143429

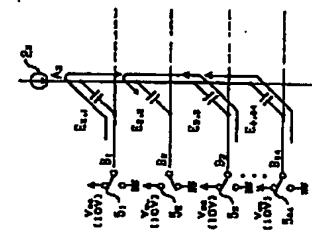
[図5]



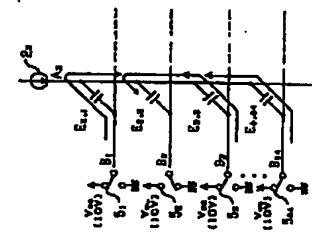
[図7]



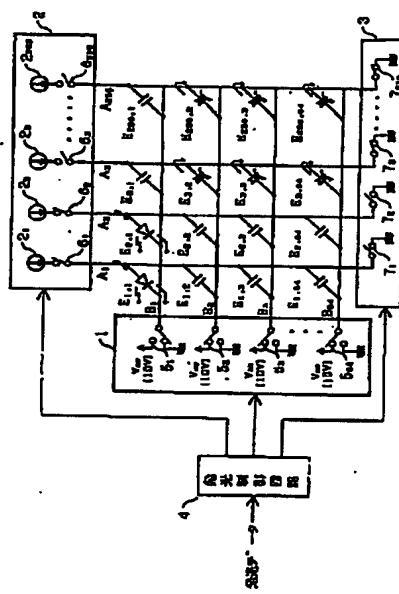
[図5]



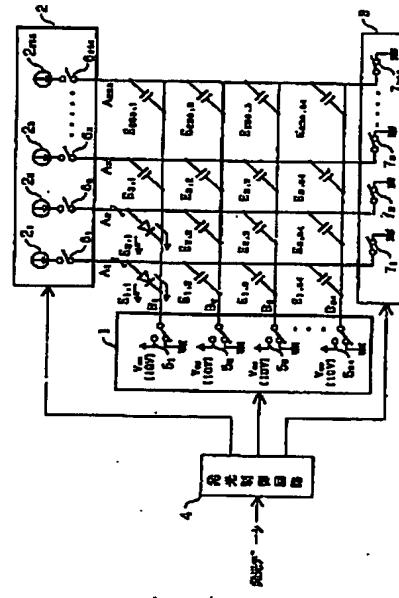
[図7]



[図6]



[図8]



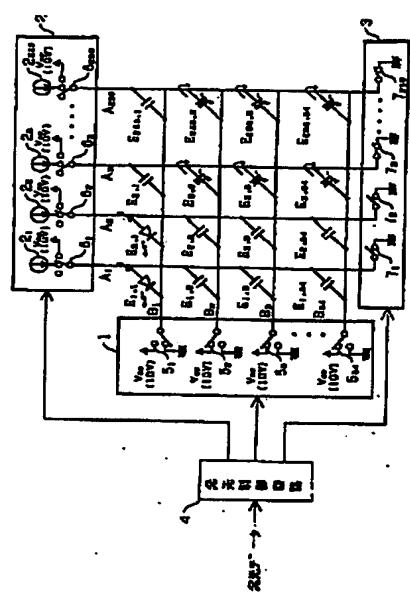
(13)

特許平11-143429

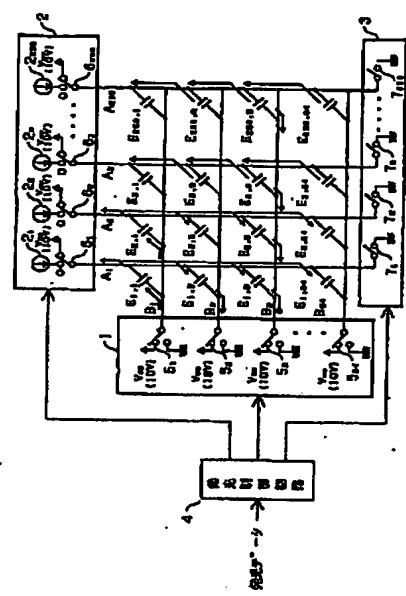
(14)

特許平11-143429

[図10]



[図11]



[図12]

